



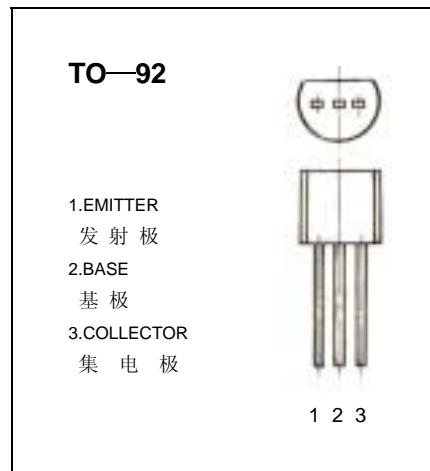
9013

NPN SILICON TRANSISTOR

FEATURES

特征

Power dissipation	(最大耗散功率)
P_{CM} : 0.625	W ($T_{amb}=25^{\circ}C$)
Collector current	(最大集电极电流)
I_{CM} : 0.5	A
Collector-base voltage	(集电极-基极击穿电压)
$V_{(BR)CBO}$: 45	V

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_{amb}=25^{\circ}C$ unless otherwise specified)

电 特 性 (环境温度 除 非 另 有 规 定)

Parameter 参 数	Symbol 符 号	Test conditions 测 试 条 件	MIN 最 小 值	TYP 典型值	MAX 最 大 值	UNIT 单 位
Collector-base breakdown voltage 集 电 极 - - 基 极 击 穿 电 压	$V(BR)_{CBO}$	$I_C= 100 \mu A, I_E=0$	45			V
Collector-emitter breakdown voltage 集 电 极 - - 发 射 极 击 穿 电 压	$V(BR)_{CEO}$	$I_C= 0.1 mA, I_B=0$	25			V
Emitter-base breakdown voltage 发 射 极 - - 基 极 击 穿 电 压	$V(BR)_{EBO}$	$I_E= 100 \mu A, I_C=0$	5			V
Collector cut-off current 集 电 极 - - 基 极 截 止 电 流	I_{CBO}	$V_{CB}= 40 V, I_E=0$			0.1	μA
Collector cut-off current 集 电 极 - - 发 射 极 截 止 电 流	I_{CEO}	$V_{CE}= 20 V, I_B=0$			0.1	μA
Emitter cut-off current 发 射 极 - - 基 极 截 止 电 流	I_{EBO}	$V_{EB}= 5 V, I_C=0$			0.1	μA
DC current gain(note) 直 流 电 流 增 益	$H_{FE(1)}$	$V_{CE}= 1 V, I_C= 50 mA$	64		300	
	$H_{FE(2)}$	$V_{CE}= 1V, I_C=500 mA$	40			
Collector-emitter saturation voltage 集 电 极 - - 发 射 极 饱 和 压 降	$V_{CE(sat)}$	$I_C= 500 mA, I_B=50 mA$			0.6	V
Base-emitter saturation voltage 基 极 - - 发 射 极 饱 和 压 降	$V_{BE(sat)}$	$I_C= 500mA, I_B= 50 mA$			1.2	V
Base-emitter voltage 基 极 - - 发 射 极 正 向 电 压	V_{BE}	$I_E=100mA$			1.4	V
Transition frequency 特 征 频 率	f_T	$V_{CE}= 6 V, I_C= 20 mA$ $f = 30MHz$	150			MHz

CLASSIFICATION OF $H_{FE(1)}$ (分类)

Rank 档 次	D	E	F	G	H	I
Range 范 围	64-91	78-112	96-135	112-166	144-220	190-300